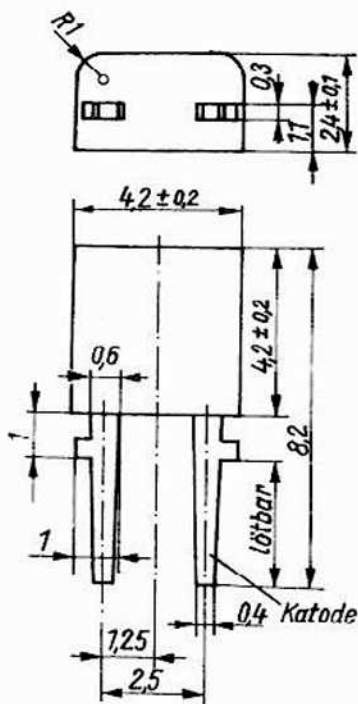
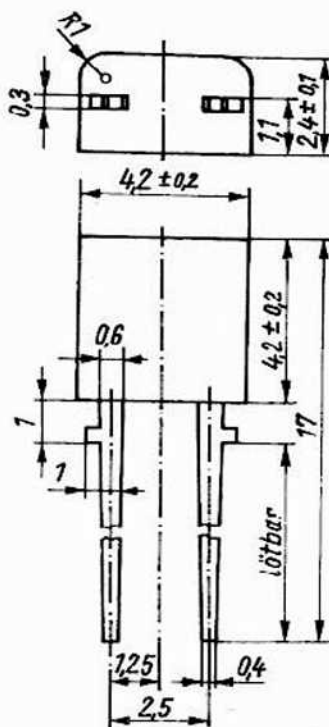


Si-Schaltdioden

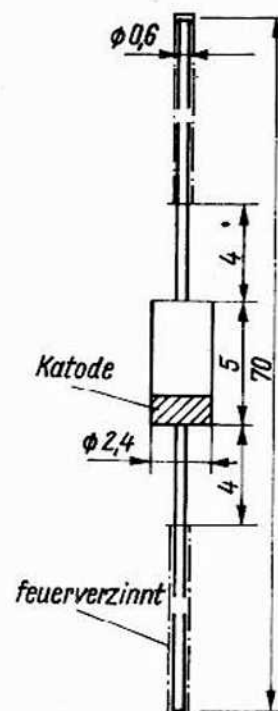
Кремниевые импульсные диоды

Si-switching diodes

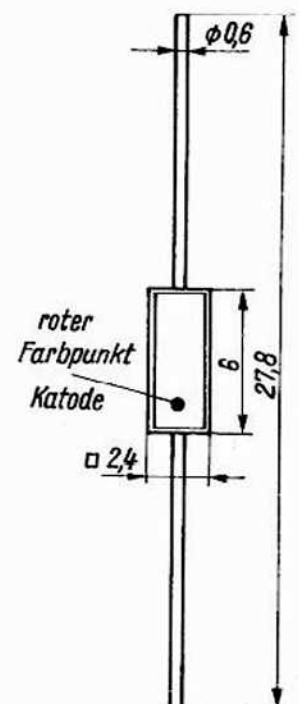
Typ	Grenzdaten bei $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$							Informationsdaten ($\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$)					
	P_{tot}	U_R	$\hat{U}_{RR}$ U_{RM}^*	I_F	$\hat{I}_{FR}$ I_{FM}^*	$\hat{I}_{FS}$	I_O	bei	bei				
	mW	V	V	mA	mA	mA	mA	U_F	I_F	I_R	U_R	C_{tot}	t_{rr}
								V	mA	μA	V	pF	ns
SAY 12	430	50	75	300	600	2000	200	<1	200	<0,1	50	<4 ¹⁾	<4 ²⁾
SAY 16	430	30	35	300	600	2000	200	<1	200	<0,1 <5	30 35	<4 ¹⁾	<4 ²⁾
SAY 17	300	50	60	175	350	2000	115	<1	100	<0,1 <5	50 60	<3 ¹⁾	<2 ²⁾
SAY 18	300	25	35	115	225	2000	75	<1	30	<0,07 <5	25 35	<4 ¹⁾	<2 ²⁾
SAY 20	300	15	20	75	150	2000	50	<1	10	<0,05 <5	15 20	<4 ¹⁾	<4 ²⁾
SAY 30	150	25	30*	30	60*	150		<0,81 >0,5	3 0,1	<0,04	25	<3 ³⁾	<65 ²⁾
SAY 32	150	25	30*	50	100*	250		<1	15	<0,04	25	<3 ³⁾	<65 ²⁾
SAY 40	150	15	20*	20	40*	100		<0,84 >0,5	3 0,1	<0,06	15	<3 ³⁾	<10 ²⁾
SAY 42	150	15	20*	30	60*	150		<1	10	<0,06	15	<3 ³⁾	<10 ²⁾
SA 403	100	25	30*	30	60*	150		<0,81 >0,5	3 0,1	<0,04	25	<3,5 ³⁾	<65 ²⁾
SA 404	100	15	20*	20	40*	100		<0,84 >0,5	3 0,1	<0,06	15	<3,5 ³⁾	<10 ²⁾

1) $U_R = 0\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$, $U_{HF} = 50\text{ mV}$ 2) beim Schalten von $I_F = 10\text{ mA}$ auf $U_R = 6\text{ V}$ 3) $U_R = 0\text{ V}$, $f = 0,5\text{ MHz}$ SAY 12 ... SAY 20
SAY 30 ... SAY 42
SA 301

SAY 12 ... SAY 20



SAY 12 ... 20



SA 403, SA 404, SA 412

Kurzzzeichen

A	wirksame Fläche	I _Z	Z-Strom	U _{CEsat}	Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung
C _c	Gehäusekapazität	ΔI _Z	Stabilität des Z-Stroms	U _{CEV}	Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei in Sperrrichtung vorge- spannter Emitterdiode
C _{gss}	Eingangskapazität	I _O	Ausgangsstrom	U _D	Blockierspannung
C _j	Sperrschichtkapazität	I _O	Richtstrom	U _{DB}	Drain-Bulk-Spannung
C _L	Lastkapazität	ΔI _O	Richtstromdifferenz	U _{DG}	Drain-Gate-Spannung
C _{tot}	Gesamtkapazität	l	Länge	U _{DM}	Scheitelblockier- spannung
CMR	Gleichtaktunter- drückung	L	Leuchtdichte	Ū _{DR}	Periodische Spitzen- blockierspannung
d _ü	Übertragungsdämpfung	L _S	Serieninduktivität	Ū _{DS}	Nichtperiodische Spitzenblockierspannung
E	Beleuchtungsstärke	N _O	Ausgangslastfaktor	U _{DS}	Drain-Source-Spannung
F	Rauschfaktor	P _{in}	HF-Eingangsleistung	U _e	Eingangsspannung
f	Frequenz	P _{RS}	Nichtperiodische Sperrverlustleistung	U _{EBO}	Emitter-Basis-Sperr- spannung
f _{h21b}	Grenzfrequenz in Basisschaltung	P _{tot}	Totale Verlustleistung	U _F	Durchlaßgleichspannung
f _{h21e}	Grenzfrequenz in Emitterschaltung	R _{äq}	Äquivalentwiderstand	U _{GB}	Gate-Bulk-Spannung
f _Q	Gütegrenzfrequenz	R _{BE}	Basis-Emitter-Wider- stand	U _{GS}	Gate-Source-Spannung
f _T	Transitgrenzfrequenz	R _{DS}	Drain-Source-Widerstand	U _{GT}	Zündspannung
G _{pb}	HF-Leistungsverstärkung in Basisschaltung	R _e	Eingangswiderstand	U _{HF}	HF-Spannung
h	Höhe	R _g	Generatorwiderstand	U _I	Gleichtakteingangs- spannung
h _{21E}	Gleichstromverstärkung	R _L	Lastwiderstand	U _{ID}	Differenzeingangs- spannung
h _{21e}	Kurzschlußstromverstär- kung in Emitterschaltung	R _{th}	Gesamtwärmewiderstand	U _{IO}	Eingangsoffsetspannung
I _B	Basisstrom	R _{thi}	Innerer Wärmewiderstand	U _R	Sperrspannung, Sperrgleichspannung
I _C	Kollektorstrom	r _F	Durchlaßwiderstand	U _{RM}	Scheitelsperrspannung
I _{CBO}	Kollektorreststrom bei offenem Emitter	r _R	Sperrwiderstand	Ū _{RR}	Periodische Spitzen- sperrspannung
I _{CES}	Kollektor-Emitter- Reststrom	r _Z	Z-Widerstand	Ū _{RS}	Nichtperiodische Spitzenperrspannung
I _{CEV}	Kollektorreststrom bei in Sperrrichtung vorge- spannter Emitterdiode	S	Empfindlichkeit	U _S	Betriebsspannung
I _D	Drainstrom	t _{DHL}	Einschaltverzögerungs- zeit	U _{SB}	Source-Bulk-Spannung
I _D	Blockierstrom	t _{DLH}	Ausschaltverzögerungs- zeit	U _T	Schwellspannung
Ū _{DR}	Drainspitzenstrom	t _{gt}	Zündzeit	U _Z	Z-Spannung
I _e	Strahlstärke	t _{off}	Ausschaltzeit	ΔU _Z	Stabilität der Z-Spannung
I _F	Flußstrom, Durchlaß- gleichstrom	t _{on}	Einschaltzeit	U _{OH}	High-Ausgangsspannung
I _F	Dauergrenzstrom	t _q	Freiwerdzeit	U _{OL}	Low-Ausgangsspannung
I _F	Effektiver Durchlaß- strom	t _r	Anstiegzeit	V _U	Spannungsverstärkung
I _{FM}	Scheiteldurchlaßstrom	t _{rr}	Sperrerrholungszeit	Y ₂₁	Steilheit
I _{FN}	Nenndurchlaßstrom, Nengleichstrom	t _s	Speicherzeit	θ _a	Umgebungstemperatur
Ū _{FR}	Periodischer Spitzen- strom	TK _{UZ}	Temperaturkoeffizient der Z-Spannung	θ _c	Gehäusetemperatur
Ū _{FS}	Nichtperiodischer Spitzenstrom	U _{AN}	Nennanschlußspannung (Effektivwert)	θ _j	Sperrschichttemperatur
I _{GT}	Zündstrom	U _{BE}	Basis-Emitter-Spannung	Δθ	Temperaturdifferenz
I _H	Haltestrom	U _(BR)	Durchbruchspannung	λ	Emissionswellenlänge
I _I	Eingangsbiassstrom	U _{CB}	Kollektor-Basis- Spannung	λ _p	Wellenlänge maximaler Emission
I _{IO}	Eingangsoffsetstrom	U _{CBO}	Kollektor-Basis- Sperrspannung	Δλ	Spektrale Halbwerts- breite
I _R	Sperrstrom	U _{CE}	Kollektor-Emitter- Spannung	τ _i	Einschaltzeitkonstante
I _T	Durchlaßstrom	U _{CEO}	Kollektor-Emitter- Sperrspannung bei offener Basis		
I _T	Dauergrenzstrom	U _{CER}	Kollektor-Emitter- Sperrspannung bei end- lichem Basis-Emitter- Widerstand		
I _T	Effektiver Durchlaßstrom	U _{CERest}	Kollektorrestspannung		
Ū _{TR}	Periodischer Spitzen- strom	U _{CES}	Kollektorsperrspannung bei kurzgeschlossenem Emitterdiode		